

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公表番号】特表2003-532791(P2003-532791A)

【公表日】平成15年11月5日(2003.11.5)

【出願番号】特願2000-502233(P2000-502233)

【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 14/34

B 2 1 J 5/00

C 2 2 C 27/02

// H 0 1 L 21/203

【F I】

C 2 3 C 14/34 A

B 2 1 J 5/00 E

C 2 2 C 27/02 1 0 3

H 0 1 L 21/203 S

【手続補正書】

【提出日】平成15年5月27日(2003.5.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

多結晶性金属スパッタリングターゲットであって、4%を超えない表面状態の配向性コンテンツ比の分散率を有していることを特徴とするスパッタリングターゲット。

【請求項2】

多結晶性金属スパッタリングターゲットであって、平均粒子サイズで3%を超えない分散率と、配向性コンテンツ比で4%を超えない分散率とを有していることを特徴とするスパッタリングターゲット。

【請求項3】

6 μmの平均粒子サイズを含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項4】

A1、Ti、Ta、Cu、Nb、Ni、Mo、Au、Ag、Re及びPtから選択される物質を含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項5】

アルミニウムを含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項6】

チタニウムを含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項7】

タンタラムを含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項8】

銅を含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスペッタリングターゲット。

**【請求項 9】**

ニッケルを含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスペッタリングターゲット。

**【請求項 10】**

精微な冶金構造と表面状態とを備えた金属物体を製造する方法であつて、

金属ビレットを提供するステップと、

該金属ビレットをその金属の再結晶温度以下である鍛造温度にまで加熱するステップと、  
鍛造処理中に摩擦を減少させるため、前記金属ビレットを鍛造する鍛造機械のプレスプレートと、鍛造される該金属ビレットの両端との間に固形潤滑剤を提供するステップと、  
該金属ビレットを 70 % から 90 % の減厚率で望むビレット厚に鍛造するステップと、  
鍛造された該金属ビレットを室温にまで冷却させるステップと、

略均質なストレイン分布状態とすべく 1 回毎に厚みを減少させるように該金属ビレットを  
圧延してプレートとするステップと、

該プレートを再結晶アニール処理するステップと、

を含んで構成されていることを特徴とする製造方法。